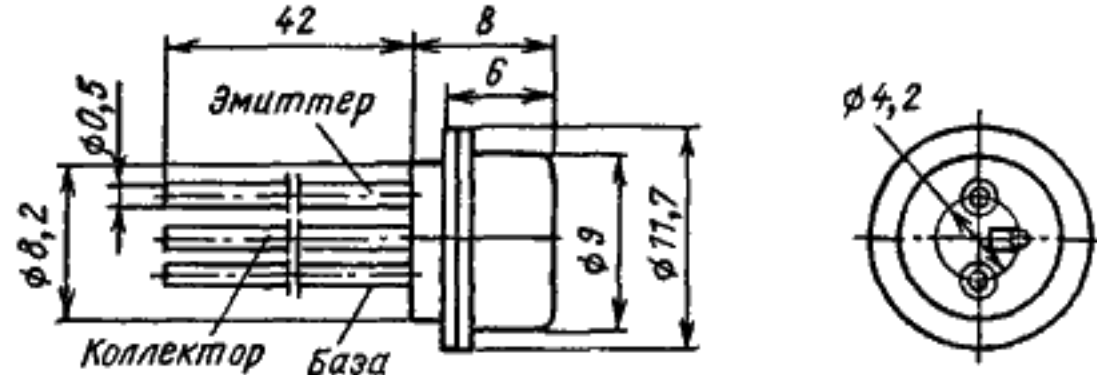


**2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И,  
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д,  
КТ603Е**

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в импульсных и переключа-  
тельных высокочастотных схемах



### Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

при  $I_K = 150$  мА,  $I_B = 15$  мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более . . . . .	0,8 В
типовое значение . . . . .	0,2* В
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	
не более . . . . .	1,0 В
при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более . . . . .	1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер:

при  $I_K = 150$  мА,  $I_B = 15$  мА:

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б,	
КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более . . . . .	1,5 В
типовое значение . . . . .	0,9* В
при $I_K = 350$ мА, $I_B = 50$ мА 2Т603И не более . . . . .	1,3 В
типовое значение . . . . .	1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КБ} = 2$  В

при  $T = 298$  К:

при  $I_3 = 150$  мА.

2Т603А, 2Т603В, КТ603Д . . . . .	20 — 80
КТ603А, КТ603В . . . . .	10 — 80
2Т603Б, 2Т603Г . . . . .	60 — 180
КТ603Б, КТ603Г не менее . . . . .	60
КТ603Е . . . . .	60 — 200

при  $I_3 = 350$  мА 2Т603И не менее . . . . .

типовое значение . . . . . 20

при  $T = 213$  К,  $I_3 = 150$  мА:

2Т603А, 2Т603В . . . . .	8 — 80
2Т603Б, 2Т603Г . . . . .	20 — 180
2Т603И не менее . . . . .	8

при  $T = 398$  К,  $I_3 = 150$  мА:

2Т603А, 2Т603В . . . . .	20 — 180
2Т603Б, 2Т603Г . . . . .	60 — 400
2Т603И не менее . . . . .	20

Время рассасывания при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не более	70 нс
типичное значение	40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	
не более	100 нс
Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, $f = 5$ МГц не более	
типичное значение	400 пс
	25* пс
Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, не менее	
типичное значение	200 МГц
	370* МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 5$ МГц	
не более	15 пФ
типичное значение	3* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$ , $f = 5$ МГц	
не более	40 пФ
типичное значение	35* пФ
Обратный ток коллектора, не более	
при $T = 298$ К при $U_{КБ} = 30$ В	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	3 мкА
КТ603А, КТ603Б	10 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В	
2Т603В, 2Т603Г	3 мкА
КТ603В, КТ603Г	5 мкА
при $U_{КБ} = 10$ В КТ603Д, КТ603Е	
	1 мкА
при $T = 398$ К	
при $U_{КБ} = 24$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И	60 мкА
при $U_{КБ} = 12$ В 2Т603В, 2Т603Г	60 мкА
Обратный ток эмиттера не более	
при $U_{ЭБ} = 3$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е	
	3 мкА
при $U_{ЭБ} = 4$ В 2Т603И	
	3 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} \leq 1$  кОм

при  $T_n \leq 343$  К

КТ603А, КТ603Б . . . . . 30 В

КТ603В, КТ603Г . . . . . 15 В

КТ603Д, КТ603Е . . . . . 10 В

при  $T_n \leq 373$  К

2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . . 30 В

2Т603В, 2Т603Г . . . . . 15 В

при  $T_n = 393$  К

КТ603А, КТ603Б . . . . . 15 В

КТ603В, КТ603Г . . . . . 7,5 В

КТ603Д, КТ603Е . . . . .	10 В
при $T = 398$ К:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . .	24 В
2Т603В, 2Т603Г . . . . .	12 В
при $T = 423$ К:	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . .	18 В
2Т603В, 2Т603Г . . . . .	9 В
<b>Напряжение эмиттер-база.</b>	
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г . . . . .	3 В
2Т603И при $T_{\text{н}} \leq 343$ К . . . . .	4 В
2Т603И при $T_{\text{н}} = 398$ К . . . . .	3 В
<b>Постоянный ток коллектора . . . . .</b>	<b>300 мА</b>
<b>Импульсный ток коллектора при <math>\tau_{\text{н}} \leq 10</math> мкс,</b>	
<b><math>Q \geq 10</math> . . . . .</b>	<b>600 мА</b>
<b>Постоянная рассеиваемая мощность:</b>	
при $T \leq 323$ К . . . . .	0,5 Вт
при $T = 358$ К КТ603А, КТ603Б, КТ603В,	
КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398$ К 2Т603А,	
2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . . . .	0,12 Вт

